

ОТЗЫВ

о научной деятельности соискателя ученой степени
кандидата физ.-мат. наук Герта Антона Владимировича

А. В. Герт начал работу в Секторе теории оптических и электрических явлений в полупроводниках ФТИ им. А. Ф. Иоффе в 2012 г., поступив в аспирантуру Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе. С самого начала работы он не только успешно осваивал методы теоретической физики, но и активно включился в работу, связанную с моделированием кремниевых наноструктур.

К настоящему времени им выполнен цикл работ по моделированию и теоретическому исследованию электронных процессов и оптических явлений в кремниевых и германиевых нанокристаллах, а также моделированию электронных состояний в силицине (кремниевом аналоге графена).

Антон Герт успешно выступал с докладами на ведущих российских и международных конференциях: XI Российская конференция по физике полупроводников (С.-Петербург 2013), XII Российская конференция по физике полупроводников (Звенигород, 2015), EMRS Spring meeting (Лилль, Франция, 2014), EMRS Spring meeting (Лилль, 2016) и др.

Я считаю, что в настоящее время А. В. Герт является вполне сформировавшимся учёным, способным вести самостоятельные исследования. Полагаю, что он достоин присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 «Физика полупроводников».

Научный руководитель,
г.н.с. ФТИ им. А.Ф. Иоффе,
проф., д.ф.-м.н.

И. Н. Ясиевич

Ученый секретарь
ФТИ им. А. Ф. Иоффе,
д.ф.-м.н.

А.П. Шергин